

SEMI スタandard集日本語版 CD ROM(0310) 全リスト

- 製造装置ハードウェア(Equipment Automation / Hardware)
- 製造装置ソフトウェア(Equipment Automation / Software)
- 設備(Facilities)
- フラットパネルディスプレイ(FPD)
- ガス(Gases)
- 材料(Materials)
- マイクロリソグラフィ(Microlithography)
- パッケージング(Packaging)
- 太陽光発電(Photovoltaic)
- プロセスケミカル(Process Chemicals)
- 安全ガイドライン(Safety Guidelines)
- シリコンマテリアル&テスト方法(Silicon Materials & Process Control)
- トレーサビリティ(Traceability)

一覧表についてのご注意

表の備考欄には、日本語版(0310)にて出版上変更のあったStandardについて、以下を記載しております。

- ◆ 「新規」→ 新しく作成されたStandard。
- ◆ 「改訂(Technical Revision)」→ すでにあるStandardに改訂が加えられたStandard。
- ◆ 「時限付き改訂(Delayed Revision)」→ 改訂年月の後にアルファベットの小文字が付いている。変更部分が有効になるのが次の(時限付きでない通常の)改訂(改訂年月を示す4桁の数字が変更になる)まで保留とされる。ただし、次の(通常)改訂以前に時限付き改訂部分を実装することは任意である。
 - 例「S2-0706a」→ 2006年7月出版のStandardに時限付きで改訂されたStandard。
- ◆ 「編集上の修正(Editorial Change)」→ 技術的内容でなく編集上の誤りなどを修正したStandard。改訂年月の後に上付きの「E」が付いている。
 - 例「S8-0307^E」→ 2007年3月出版のStandardに編集上の修正が加えられたもの。
- ◆ 「再承認(Reapproved)」→ そのままの内容で再度承認されたStandard。
 - 例「E57-0600(Reapproved 0305)」→ 2000年6月のStandardがそのままの内容で2005年3月に再度承認されたもの。
- ◆ 「撤回(Withdrawn)」→ 出版停止が決まったStandard。撤回が決定となった後1年間は引き続き出版されるが、その翌1年間は撤回となった旨明示されStandard自体は掲載されなくなる。
 - 例「E2-93(撤回 1103)」→ 1993年のStandardが2003年11月の出版サイクルより撤回とされ、2004年7月版まで引き続き出版されたがそれ以降は出版されなくなった。このStandard撤回となった旨2005年7月版まで本文に替わって記載される。
- ◆ 「掲載停止」→ 実質上他のStandardに含まれた、などの理由で、その番号での出版は行っていないStandard。
- ◆ 「翻訳修正」→ 原文(英語版)は改訂など行われていないが、日本語版のみ修正が加えられたStandard。

製造装置ハードウェア (Equipment Automation / Hardware)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
E1-0310	プラスチックおよびメタルのウェーハキャリアの仕様	改訂	1
E1.1-0697 (Reapproved 1102)	3 インチプラスチックおよびメタルウェーハキャリア(一般用)		2
E1.2-0697 (Reapproved 1102)	100 mm プラスチックおよびメタルウェーハキャリア(一般用)		3
E1.3-0697 (Reapproved 1102)	125 mm プラスチックおよびメタルウェーハキャリア(一般用)		4
E1.4-0697 (Reapproved 1102)	125 mm プラスチックおよびメタルウェーハキャリア(自動搬送用)		5
E1.5-91 (Reapproved 1102) E	150 mm プラスチックおよびメタルウェーハキャリア(一般用)		6
E1.9-1106E	300 mmウェーハ搬送および保管用ウェーハカセットの機械仕様		7
E6-0303	半導体製造装置の設置に関する文書のガイド		Facil.
E7-91 (Reapproved 1104)	米国用電氣的インタフェースの仕様		8
E10-0304E	半導体製造装置の信頼性、有用性、整備性の定義と測定のための仕様		9
E12-0303 (Reapproved 0309)	マスフローメータおよびマスフローコントローラに使用される標準の圧力、温度、密度、および流量単位のスタンダード		Facil.
E15-0698 E2 (Reapproved 0310)	ツールロードポートの仕様	再承認	10
E15.1-0305	300 mm装置ロードポートのための仕様		11
E16-90 (Reapproved 1104)	マスフローコントローラ漏洩率の決定および記述(ガイドライン)		Facil.
E17-0600 (Reapproved 0307)	マスフローコントローラの過渡特性テストのガイドライン		Facil.
E18-91 (Reapproved 1104)	マスフローコントローラの温度スペック(ガイドライン)		Facil.
E19-0309	標準メカニカルインタフェース(SMIF)のスタンダード		12
E19.1-0309	メカニカルインタフェース用100 mm (4in)ポートの仕様スタンダード		13
E19.2-0309	メカニカルインタフェース用125 mm (5 in)ポートの仕様スタンダード		14
E19.3-0309	メカニカルインタフェース用150 mm (6 in)ポートの仕様スタンダード		15
E19.4-0998E (Reapproved 0709)	200 mm標準メカニカルインタフェース(SMIF)のスタンダード		16
E20-0697 (Reapproved 1102)	クラスタツール・モジュール・インタフェース: 電源および緊急停止		17
E21-94 (Reapproved 0309)	クラスタツール・モジュール・インタフェース: メカニカル・インタフェースおよびウェーハ搬送		18
E21.1-0309	クラスタツール・モジュール・インタフェース: 300 mm メカニカルインタフェースおよびウェーハ搬送		19
E22-0697 (Reapproved 0309)	クラスタツール・モジュール・インタフェース: 搬送モジュール・エンドエフェクタ・排除領域		20
E22.1-0309	クラスタツール・モジュール・インタフェース: 300 mm 搬送モジュール・エンドエフェクタ・排除領域		21
E23-1104	カセット搬送パラレルI/Oインタフェースのための仕様		22
E24-92 (Reapproved 0704)	クラスタツール・モジュール・インタフェース: 隔離バルブインタロックのスタンダード		23
E27-92 (Reapproved 1104)	マスフローコントローラおよびマスフローメータの直線性のスタンダード		Facil.
E28-92 (Reapproved 1104)	マスフローコントローラの圧力仕様のガイドライン		Facil.
E29-93 (Reapproved 1104)	マスフローコントローラおよびマスフローメータの校正のための標準用語		Facil.
E31-93	電氣的インタフェース(日本用)		Facil.
E33-94	半導体製造設備の電磁適合性のための仕様		24
E34-95	マスフローデバイス返還のためのガイドライン		Facil.
E35-0307	半導体製造装置のCOO 測定方法の計算ガイド		25
E43-1108	オブジェクトおよび表面上の静電気測定のための推奨実施方法		26
E45-1101 (Reapproved 0307)	気相分解-全反射X線分光法(VPD/TXRF), 気相分解-原子吸収分光法(VPD/AAS), 気相分解-誘導結合プラズマ質量分光法(VPD/ICP-MS)を使用したミニエンパイロメントからの無機汚染分析のための試験方法		27
E46-0307	イオン移動度分光計(IMS)を使用したミニエンパイロメントからの有機汚染分析の試験方法		28
E47-0301 (Reapproved 1106)	150 mm/200 mm用ポッドハンドルの仕様		29
E47.1-1106	300 mmウェーハ搬送および保管用FOUPの機械仕様		30
E48-1101 (Reapproved 1107)	SMIFインデクサ用空間のための仕様		31
E49-1104	高純度および超高純度配管システムの性能、サブアセンブリ、最終組立のためのガイド		Facil.
E49.2-1104	半導体処理装置の超純水システムおよび薬液システムで使用されるポリマーアセンブリの資格認定のガイドライン		Facil.
E49.4-0298	半導体製造装置における高純度溶剤供給システムのガイド		Facil.
E49.5-1104	半導体製造装置における超高純度溶剤供給システムのガイド		Facil.
E49.6-1103	サブシステム組立ておよびテスト手順のガイド-ステンレススチールシステム		Facil.
E49.7-0304E	半導体プロセス装置内の超純水およびリキッドケミカルシステムの設計および製造に対する純度のガイド		Facil.

製造装置ハードウェア (Equipment Automation / Hardware)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
E49.8-1103	半導体製造装置における高純度および超高純度ガス供給システムのガイド		Facil.
E51-0200	一般的設備サービスおよび終端マトリクスのガイド		Facil.
E52-0310	デジタルマスフローコントローラで使用されるガス、ガス混合物および気化して使用する材料の参照表	改訂	Facil.
E56-0309	熱マスフローコントローラの精度、直線性、リピータビリティ、短期再現性、ヒステリシス(履歴現象)およびデッドバンドを判断するテスト方法		Facil.
E57-0600(Reapproved 0305)	300 mmウェーハキャリアの位置決めおよび支持のために使用されるキネマティックカブリングの機械仕様		32
E62-1106	300 mmフロントオープニング・メカニカルインタフェース(FIMS)の仕様		33
E63-1104	300 mmボックスオープナ/ローダーと装置間のスタンダード(BOLTS-M)インタフェースの機械的仕様		34
E64-1105	SEMI E15.1ドッキングインタフェースポートと300 mmカートの仕様		35
E66-1103	マスフローコントローラのパーティクル発生測定のためのテスト方法		Facil.
E67-0304	マスフローコントローラの信頼性測定のためのテスト方法		Facil.
E68-0997(Reapproved 0309)	マスフローコントローラのウォームアップ時間測定のためのテスト方法		Facil.
E69-0298(Reapproved 0309)	サーマルマスフローコントローラの再現性とゼロドリフトを測定するためのテスト方法		Facil.
E70-1103	ツール・アコモデーションのプロセスに対するガイド		Facil.
E72-0600(Reapproved 0305)	300 mm装置の床面積、高さ、重量の仕様ならびにガイド		36
E73-0301(Reapproved 0307)	真空ポンプのインタフェースの仕様 - ドライポンプ		37
E74-0301(Reapproved 0307)	真空ポンプのインタフェースの仕様 - ターボモレキュラーポンプ		38
E76-0299	300 mmプロセス装置を設備サービスに接続するポイントのガイド		Facil.
E77-1104	マスフローコントローラの換算率の代用ガス使用による計算方法		Facil.
E78-0309	装置のための静電気放電(ESD)と静電気吸引(ESA)の評価と制御へのガイド		39
E79-1106	装置生産性の定義と測定に関する仕様		40
E80-0299(Reapproved 1104)	マスフローコントローラの姿勢感度(取付位置)決定の試験方法		Facil.
E83-1106	300 mm PGVメカニカルドッキングフランジの仕様		41
E84-1109	エンハストキャリア移載パラレルI/Oインタフェースの仕様		42
E85-1108	ベイ間搬送システム用AMHSストッカーの共用性に関する仕様		43
E89-0707	測定システム分析(MSA)のガイド		44
E92-0302E(Reapproved 0709)	軽量小型の300 mmボックスオープナ/ローダーとツールの互換スタンダード(BOLTS/Light)		45
E99-1104E	キャリアIDリーダー/ライタ機能スタンダード:コンセプト、挙動、およびサービスに関する仕様		Soft.
E99.1-1104	キャリアIDリーダー/ライタ機能規格のためのSECS-IおよびSECS-IIプロトコル仕様		Soft.
E100-1104	6インチまたは230 mmのレチクルの搬送および保管に用いられるレチクルSMIFポッド(RSP)の仕様		46
E101-1104	EFEM機能構造モデルのガイド		47
E103-0704	FOUPをエミュレートする300 mm枚葉ウェーハボックスシステム用機械仕様		48
E104-0303	低圧パーティクル・モニタ校正のガイドラインおよび装置組み込みのための仕様		49
E106-1104	300 mm物理的インタフェースおよびキャリアに関するSEMIスタンダードオーバービューガイド		50
E108-0307	ガスクロマトグラフィ/質量分析法を使用したミニエンバイロメントからの有機汚染放出ガスを評価するための試験方法		51
E110-1102(Reapproved 0709)	300 mmロードポート用ロードポート操作インタフェースの表示器設置ゾーンおよびスイッチ設置ボリュームについてのガイドライン		52
E111-1106	6インチレチクルの搬送および保管用150 mmレチクルSMIFポッド(RSP150)の機械仕様		53
E112-1106	6インチレチクルの搬送および保管用150 mm複数レチクルSMIFポッド(MRSP150)の機械仕様		54
E113-0306	半導体処理装置の高周波(RF)電力供給システム用仕様		55
E114-0302E(Reapproved 0309)	半導体処理装置の高周波(RF)電力供給システムに使う高周波ケーブルアセンブリ用テスト方法仕様		56
E115-0302E(Reapproved 0309)	半導体処理装置RF電力供給システムに使われる整合回路網の負荷インピーダンスと効率を決めるための試験方法		57
E117-1104	レチクルロードポートの仕様		58
E118-1104E	ウェーハIDリーダー通信インタフェースの仕様-ウェーハIDリーダーの機能スタンダード:概念、動作、サービス(WIDR)		Soft.

製造装置ハードウェア (Equipment Automation / Hardware)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
E118.1-1104	ウェーハリーダー通信インタフェース標準のSECS-I, SECS-IIプロトコル仕様		Soft.
E119-0706	300 mmウェーハの工場間輸送用狭ピッチフロントオープニングボックス (FOBIT) の機械仕様		59
E124-1107	総合工場効率 (OFE) およびその他の工場レベルの生産性測定基準の定義とその計算法についてのガイド		60
E129-0709	半導体製造設備における静電気放電 (ESD) の評価と制御へのガイド		61
E131-0304(Reapproved 0310)	BOLTS-Mを使用する装置組込み測定モジュール (IMM) と300 mmツールとの物理的インタフェースの仕様	再承認	62
E135-0704	半導体処理装置の高周波 (RF) 電力供給システムの過渡応答を決定するためのRF発振器のテスト方法		63
E136-1104	半導体処理装置のRF電力供給システムで使用されるRF電源の出力を決定するためのテスト方法		64
E137-0705	半導体製造装置の最終組立, 梱包, 輸送, 開梱, クリーンルームの製造領域への移送のためのガイド		Facil.
E140-0305	ガス配送システムのコストオブオーナーシップ (COO) の計算ガイド		65
E141-0705	装置組込み型測定に用いるエリプソメーター装置の仕様についてのガイド		66
E143-0306	50Ωの負荷に対する出力変動の測定およびすべての位相角において電圧定在波比が2.0の負荷に対する出力変動とスペクトルを測定するための試験方法		67
E144-0306	半導体製造装置および材料ハンドリング装置におけるキャリア内のRFIDタグとRFIDリーダーの間の無線インタフェースの暫定仕様		68
E146-0306	シリコンウェーハの保管および運搬に使用するミニエンパイロメントからのパーティクル汚染を測定するための試験方法		69
E149-0708	製造装置の取得および使用について装置サプライヤが提供する文書に関するガイド		70
E150-1107	装置トレーニングのベストプラクティスに関するガイド		71
E152-0709	150 mm EUVLレチクル用EUVポッドの機械仕様		72
E154-0310	450mmロードポートのためのメカニカルインタフェースの仕様	新規	73
D16-0998	FPDマテリアルハンドリングシステムとツールポート間の機械的インタフェース仕様		FPD
F32-0709	高純度遮断バルブの容量係数を求めるための試験方法		Facil.
F47-0706	半導体プロセス装置電圧サグ対応力のための仕様		Facil.
G77-0699(Reapproved 0706)	300 mmウェーハ用フレームカセットの仕様		Pack.
G82-0301E(Reapproved0706)	後工程におけるフレームカセット用300mmロードポート暫定仕様		Pack.
M31-0708	300 mmウェーハの搬送および出荷用フロントオープニング・ SHIPPINGボックスの機械仕様		Mate.
AUX010-0304	User Interface Configurations For 300-mm Equipment Load Ports		--
AUX012-0705	300 mm FOUP/Load Port Interoperability Report Proceedings of the International Workshop on FOUP/Load Port Interoperability		--
AUX016-0708	LIST OF CARRIER MAKER IDENTIFICATION CODES		--

製造装置ソフトウェア (Equipment Automation / Software)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
E4-0699 (Reapproved 0307)	半導体製造装置通信スタンダード1 メッセージトランスファ (SECS-I)		1
E5-0709E	半導体製造装置通信スタンダード2 メッセージ内容 (SECS-II)	編集上の修正	2
E23-1104	カセット搬送パラレルI/Oインタフェースのための仕様		Hard.
E30-0307E	製造装置の通信およびコントロールのための包括的モデル (GEM)		3
E30.1-0309	検査および評価特定装置モデル (ISEM)		4
E30.5-0302 (Reapproved 0308)	計測装置の特定装置モデル		5
E32-0997	材料搬送管理スタンダード (MMM)		6
E32.1-0997	材料搬送へのSECS-IIのサポート		7
E36-0704	半導体装置製造情報タグ付け仕様		8
E36.1-0704	E36半導体装置製造情報タグ付けスタンダードの仕様		9
E37-1109	高速SECSメッセージサービス (HSMS) 汎用サービス		10
E37.1-0702 (Reapproved 0308)	単一の選択セッションにおける高速SECS メッセージサービス (HSMS-SS あるいはHSMS-SSS)		11
E37.2-95 (withdrawn 1109)	高速SECS メッセージサービス ジェネラルセッション (HSMS-GS)		12
E39-0703 (Reapproved 1109)	オブジェクトサービススタンダード (OSS) : 概念, 挙動およびサービス		13
E39.1-0703 (Reapproved 1109)	オブジェクトサービススタンダード (OSS) のためのSECS-IIプロトコル		14
E40-0709	プロセス管理スタンダード (PJM)		15
E40.1-1106	プロセス管理スタンダード (PJM) へのSECS-IIのサポート		16
E41-95	例外処理スタンダード		17
E41.1-0996	例外処理スタンダードへのSECS-IIのサポート		18
E42-0704	レシピ管理スタンダード: コンセプト, 挙動, およびメッセージサービス		19
E42.1-0704	レシピ管理スタンダード (RMS) のためのSECS-II プロトコル スタンダード		20
E53-0704	イベントレポート (ERS)		21
E53.1-0704	イベントレポートスタンダードへのSECS-IIのサポート		22
E54-0708	センサ/アクチュエータネットワークのスタンダード		23
E54.1-0708	センサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 共通デバイスモデルのスタンダード		24
E54.2-0698 (Reapproved 0704)	センサ/アクチュエータネットワーク (SAN) スタンダードパレットを書くためのガイド		25
E54.3-0698 (Reapproved 0704)	マスフローデバイスのためのセンサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 独自のデバイスモデルのためのスタンダード		26
E54.4-0704	DeviceNet 用センサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 通信スタンダード		27
E54.8-0309	PROFIBUS-DPのためのセンサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 通信に関する仕様		28
E54.9-0708	TCP/IPでのMODBUS/TCPのためのセンサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 通信に関する仕様		29
E54.10-0600 (Reapproved 1106)	in-situパーティクルモニターデバイスのためのセンサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 特定デバイスモデル仕様		30
E54.11-1106	エンドポイントデバイスのための特定デバイスモデル		31
E54.12-0701E (Reapproved 1106)	CC-LINK のためのセンサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 通信に関するスタンダード		32
E54.13-0303	EtherNet/IP™用センサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 通信の仕様		33
E54.14-0309	PROFINET用センサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 通信に関する仕様		34
E54.15-1107	SafetyBUS p用センサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 通信に関する仕様		35
E54.16-1106	LONWORKSによるセンサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 通信の仕様		36
E54.17-0706	A-LINKに関するセンサ/アクチュエータネットワーク (SAN) の規定		37
E54.18-1106	真空ポンプ機器専用のセンサ/アクチュエータネットワーク (SAN) の機器モデルの仕様		38
E54.19-0308	MECHATROLINKに関するセンサ/アクチュエータネットワークの仕様		39
E54.20-1108	EtherCAT用センサ/アクチュエータネットワーク通信に関するスタンダード		40
E58-0703	自動化による信頼性, 有用性, および整備性に関するスタンダード (ARAMS) : コンセプト, 挙動, およびサービス		41

製造装置ソフトウェア (Equipment Automation / Software)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
E58.1-0697 (Reapproved 0703)	自動化による信頼性, 有用性, および整備性に関するスタンダード (ARAMS) : コンセプト, 挙動, およびサービスのためのSECS-IIプロトコル		42
E81-0600 (Reapproved 0307)	CIMフレームワーク (CIMFW) ドメインアーキテクチャに関する暫定仕様		43
E82-1106	工程間/工程内AMHS SEMの仕様 (IBSEM)		44
E84-1109	エンハンスドキャリア移載パラレルI/Oインタフェースの仕様 (EPI/O)		Hard.
E86-0200	CIMフレームワークファクトリ従業員コンポーネントに関する暫定仕様		45
E87-0709	キャリア管理 (CMS) のための仕様		46
E87.1-0707	キャリア管理 (CMS) のためのSECS-IIプロトコルに対する暫定仕様		47
E88-0307	AMHS保管SEM (ストッカーSEM) の仕様		48
E90-0707	基板トラッキング仕様 (STS)		49
E90.1-0706	SECS-IIプロトコル基板トラッキングのための暫定仕様		50
E91-0600 (Reapproved 1109)	ブローバ独自の装置モデル (PSEM) に関する仕様		51
E94-0309	コントロールジョブ管理 (CJM) の仕様		52
E94.1-1107	コントロールジョブ管理 (CJM) のためのSECS-IIプロトコル用仕様		53
E95-1101 (Reapproved 0307)	半導体製造装置のヒューマンインタフェースに関する仕様 (HCI)		54
E96-1101 (Reapproved 0307)	CIMフレームワーク (CIMFW) テクニカルアーキテクチャに関するガイド		55
E97-0200A (Reapproved 0307)	CIMフレームワーク (CIMFW) グローバル宣言および抽象インタフェースに関する暫定仕様		56
E98-0309	オブジェクトベース装置モデル (OBEM) 暫定スタンダード		57
E98.1-1102 (Reapproved 0309)	オブジェクト基盤装置モデルのためのSECS-IIプロトコル用暫定仕様		58
E99-1104E	キャリアIDリーダー/ライタ機能スタンダード: コンセプト, 挙動, およびサービスに関する仕様		59
E99.1-1104	キャリアID リーダ/ライタ機能スタンダードのためのSECS-IおよびSECS-IIプロトコル仕様		60
E102-0600 (Reapproved 0706)	CIMフレームワーク (CIMFW) マテリアル搬送・格納コンポーネントに関する暫定仕様		61
E105-0701	CIMフレームワークスケジューリングコンポーネントのための暫定仕様		62
E107-1102	歩留まり管理システムに電気的不良データを渡すためのデータフォーマット		63
E109-0305	レチクルおよびポッド管理に関する仕様 (RPMS)		64
E109.1-0704	レチクルおよびポッド管理 (RPMS) に関するSECS-IIプロトコルの暫定仕様		65
E116-0707E	装置性能トラッキング (EPT) のための仕様		66
E116.1-0707	装置性能トラッキング (EPT) のSECS-IIプロトコル仕様		67
E118-1104E	ウェーハIDリーダー通信インタフェースの仕様-ウェーハIDリーダーの機能スタンダード: 概念, 動作, サービス (WIDR)		68
E118.1-1104	ウェーハIDリーダー通信インタフェーススタンダードのSECS-I, SECS-IIプロトコル仕様		69
E120-0310	共通装置モデル (CEM) の仕様	改訂	70
E120.1-0310	共通装置モデル (CEM) のXMLスキーマ	改訂	71
E121-0305	半導体製造への応用に関するXMLスタイルと利用のガイド (XML GSL)		72
E122-0703 (Reapproved 1109)	テスト装置の特定装置モデル (TSEM) のスタンダード		73
E122.1-0703 (Reapproved 1109)	テスト特定装置モデル (TSEM) のSECS-II プロトコル仕様		74
E123-0703 (Reapproved 1109)	ハンドラ装置の特定装置モデル (HSEM) のスタンダード		75
E123.1-0703 (Reapproved 1109)	ハンドラ特定装置モデル (HSEM) のSECS-II プロトコル仕様		76
E125-0310	装置自己記述 (EqSD) の仕様	改訂	77
E125.1-0310	装置自己記述 (EqSD) のためのSOAPバインディングの仕様	改訂	78
E126-0708	装置品質情報パラメータ (EQIP) に関する仕様		79
E127-0308	装置組込み計測モジュール通信の仕様: 概念, 挙動, サービス (IMMC)		80
E127.1-0308	装置組込み計測モジュール通信のSECS-IIプロトコル仕様 (IMMC)		81
E128-0310	XMLメッセージ構造に関する暫定仕様 (XML.MS)	改訂	82
E130-1104	300mm環境のブローバ専用装置モデル (PSEM300) に関する仕様		83
E130.1-1104	300mm 環境のブローバ専用装置モデル (PSEM300) のSECS-II プロトコル仕様		84
E132-0310	装置クライアントの認証 (Authentication) および権限付与 (Authorization) のための仕様	改訂	85
E132.1-0310	装置クライアントの認証および権限付与 (ECA) のためのSOAPバインディングの仕様	改訂	86
E133-1109	自動プロセス制御システムインタフェース (PCS) の暫定仕様		87
E133.1-1107	プロセス制御システム (PCS) 用XMLメッセージングの暫定仕様		88
E134-0310	データ収集管理の仕様	改訂	89
E134.1-0310	データ収集管理 (DCM) のSOAPバインディングに関する仕様	改訂	90

製造装置ソフトウェア (Equipment Automation / Software)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
E138-0709	半導体生産系で共通に使われる情報の構成要素のXML表現		91
E139-0310	レシピとパラメータに関する管理の規定 (RaP)	改訂	92
E139.1-0310	RaP PDEのためのXMLスキーマ	改訂	93
E139.2-1108	レシピとパラメータ管理に関するSECS-IIプロトコル (RaP)		94
E139.3-0310	レシピとパラメータ管理に関するXML/SOAPバインディング	改訂	95
E142-0706	基板マッピングの仕様		96
E142.1-0706	基板マッピング用のXMLスキーマ		97
E142.2-0306	基板マッピング用SECS IIプロトコル		98
E142.3-0706	基板マッピング向けWebサービス		99
E145-0306	XMLにおける測定単位記号に関する分類		100
E147-0307E	装置データ取得 (EDA) のためのガイド		101
E148-1109	時刻同期とTS-CLOCK オブジェクト定義の仕様		102
E151-0309	データ品質を理解するためのガイド		103
E153-1109	AMHS SEMの仕様 (AMHS SEM)	改訂	104
E155-0310	MOTIONNET®用センサ/アクチュエータネットワーク (SAN) 通信に関する仕様	新規	105
G81-0307	マップデータ・アイテムの仕様 (MDI)		Pack.
G81.1-0307	基板上のダイの特性に関するマップデータの基本概念の規定		Pack.
D27-1000	FPD装置の通信インタフェースのガイド		FPD
AUX002-0600	An Overview of Factory Automation Requirements and Design		--
AUX013-0705	Equipment Supplier's Basic Operational Scenarios for Automation Version 1.00		--

設備 (Facilities)

スタンダード番号	タイトル	備考	
F1-96	高純度ガス配管系および部品の漏れ完全性仕様		1
F4-1000	空気圧動作シリンダバルブの仕様		2
F5-1101	ガス状廃棄物処理のガイドライン		3
F6-92	危険ガス配管システムの二次封じ込め(ガイドライン)		4
F7-92(Reapproved 0299)	フロロカーボン製チューブフィッティング接合部の引張り強さを測定するテスト方法		5
F8-0998	引張り力を受けた場合のフロロカーボン製チューブフィッティング接合部のシール能力を評価する試験方法		6
F9-0998	サイドロード状態に置かれた場合のフロロカーボン製チューブフィッティング接合部の漏洩特性を測定する試験方法		7
F10-0698	フッ素樹脂製チューブフィッティングに損傷を生じさせるのに必要な内部圧力を決定するためのテスト方法		8
F11-0998	フッ素樹脂製チューブフィッティングの熱的特性指標を得るための試験方法		9
F12-0998	フッ素樹脂製フィッティングの熱サイクル負荷後のシール性能決定の試験方法		10
F13-1101	ガス供給制御装置に対するガイド		11
F14-93(Reapproved 0699)	ガス供給装置筐体の設計ガイド		12
F15-0308	筐体の試験方法(六フッ化硫黄のトレーサガス)のSEMI S6への移行		13
F18-95	熱可塑性パイプおよびチューブの耐水圧強度と設計ベースを決定するためのガイド		14
F19-0304(Reapproved 0310)	ステンレススチール部品の接ガス・接液面の表面仕上げのための仕様	再承認	15
F20-0706E	高純度および超高純度の半導体製造アプリケーションで使用される汎用コンポーネント用の316Lステンレス鋼の棒鋼、鍛造品、押出成形品、鋼板、鋼管の仕様		16
F21-1102	清浄な環境における空気を媒体とする分子汚染レベルの分類		17
F22-1102	ガス供給システムガイド		18
F23-0697(Reapproved 0303)	グレード10/0.2 引火性特殊ガスの粒子に関する仕様		19
F24-0697(Reapproved 0303)	グレード10/0.2 不活性特殊ガスの粒子に関する仕様		20
F25-0697(Reapproved 0303)	グレード10/0.2 酸化体特殊ガスの粒子に関する仕様		21
F26-0697(Reapproved 0303)	グレード10/0.2 有毒特殊ガスの粒子に関する仕様		22
F27-0997(Reapproved 1103)	ガス配分システムおよび部品の水分相互作用および含有量の大气圧電離質量分析(APIMS)による、テスト方法		23
F28-1103	プロセスパネルからのパーティクル発生を測定するテスト方法		24
F29-0997(Reapproved 1103)	ガスソースシステムパネルのページ効果のテスト方法		25
F30-0298	据付現場における微量ガス不純物およびパーティクルに関する精製器性能テストの始動および検証		26
F31-0698	バルク化学薬品配分システムのガイド		27
F32-0709	高純度遮断バルブの容量係数を求めるための試験方法		28
F33-0708	気圧イオン化質量分析計(APIMS)の較正のためのテスト方法		29
F34-0998	液体化学薬品配管ラベリングに関するガイド		30
F35-0304	非浸入式酸素測定を使用した超高純度ガス分配システムの安全性を確認するためのテスト方法		31
F36-0299(Reapproved 1104)	ガス分配部品の寸法と接続に関するガイド		32
F37-0299(Reapproved 1104)	ガス供給システム構成部品の表面粗さパラメータの算出方法		33
F38-0699(Reapproved 1104)	ユースポイントガスフィルタの効率資格付けを目的とした試験方法		34
F39-0699	化学薬品混合システムに関するガイドライン		35
F40-0699E	化学試験のための薬液分配部品の準備についての作業方法		36
F41-0699	半導体プロセスで使用されるバルク化学薬品分配システムの検定に関するガイド		37
F42-0600	半導体プロセス装置の電圧サグに対する感受率の試験方法 2006年7月、F42はF47に書き換えられました。		--
F43-0308	ユースポイントガス精製器およびガスフィルタによるパーティクルに対する寄与度を定量化するための試験方法		38
F44-0307	機械加工されたステンレス鋼製溶接継手の仕様		39
F45-0307	機械加工されたステンレス鋼製異径溶接継手の仕様		40
F46-0999	現場化学薬品調製(OSCG)システムに関するガイド		41
F47-0706	半導体プロセス装置電圧サグ対応力のための仕様		42
F48-0600(Reapproved 0709)	高分子材料中の微量金属を検出するための試験方法		43

設備 (Facilities)

スタンダード番号	タイトル	備考	
F49-0200(Reapproved 1108)	半導体工場システムの電圧サグイミュニティに関するガイド		44
F50-0200(Reapproved 1108)	半導体工場の電気ユーティリティ電圧サグ性能に関するガイド		45
F51-0200	エラストメトリックシーリング技術に関するガイド		46
F52-1101	半導体およびFPD製造の薬液供給システム用メトリックPFAチューブの寸法仕様		47
F53-0600(Reapproved 0307)	サーマル・マスフローコントローラの電磁感受性評価の試験方法		48
F54-1000	凝縮核カウンタの計数効率を測定するための試験方法		49
F55-0600(Reapproved 0307)	マスフローコントローラの耐腐食性を求めるための試験方法		50
F56-0600(Reapproved 0307)	マスフローコントローラの定常供給電圧の影響を測定するための試験方法		51
F57-0301	超純水および液体化学薬品配分システム内に使用するポリマー製部品の暫定仕様		52
F58-0708	大気圧イオン化質量分析計(APIMS)による表面実装および一般的ガス配分システムの水分ドライダウン特性測定のためのテスト方法		53
F59-0302(Reapproved 1108)	フィルタまたはガス供給システムの流圧測定テスト方法		54
F60-0306	不動態化した316Lステンレス・スチール部品の接ガス表面の組成をESCAにより評価する試験方法		55
F61-0301(Reapproved 0309)	半導体プロセスに使用する超純水システムに対するガイド		56
F62-0701(Reapproved 0307)	周囲およびガス温度の影響からマスフローコントローラ性能特性を決定する試験方法		57
F63-0309	半導体処理に使用する超純水に対するガイドライン		58
F64-0701(Reapproved 0307)	マスフローコントローラの指示および実流量に対する圧力影響を測定する試験方法		59
F65-1101	PFAチューブとともに使用するダイアフラムパルプの取付ベースの寸法仕様		60
F66-1101	ステンレス製薬液容器のポート標記および記号の仕様		61
F67-1101(Reapproved 1108)	不活性ガス精製装置キャパシティを決定するテスト方法		62
F68-1101(Reapproved 1108)	精製器の効率を測定するためのテスト方法		63
F69-0708	ガス供給システムの搬送および衝撃試験のテスト方法		64
F70-0302	ガス供給システムからのパーティクル発生を測定するための試験方法		65
F71-1102	ガス供給システムの温度サイクル試験方法		66
F72-0309	不動態化処理した316Lステンレス鋼部品の接ガス表面の酸化膜のオージェ電子分光法(AES)による評価試験方法		67
F73-0309	ステンレス鋼部品の接ガス表面状態の走査型電子顕微鏡(SEM)による評価テスト方法		68
F74-1103	ガス供給システムに使用されるメタルシールの性能と評価のためのテスト方法		69
F75-1102(Reapproved 0309)	半導体製造に使用される超純水の品質監視ガイド		70
F76-0303	腐食性ガスに曝露されるガスシステム内の各コンポーネントからのパーティクル発生を評価するテスト方法		71
F77-0703(Reapproved 0310)	腐食性のガスシステムに使用される合金表面の電気化学的臨界孔食温度のテスト方法	再承認	72
F78-0304	半導体製造用途における流体配管システムのガスタングステンアーク(GTA)溶接の作業方法		73
F79-0703	ガス分配コンポーネントに使用されるガスのシリコンとの適合性に関するガイドライン		74
F80-0309	ガス供給システムのガス切り替え/パージ効果を確認するためのテスト方法		75
F81-1103	半導体製造用途における流体配管システムのガスタングステンアーク(GTA)溶接の目視検査および検収の仕様		76
F82-0304	1.125インチタイプサーフェスマウント型ガス供給システム用マスフローコントローラ/マスフローメータの寸法のための仕様		77
F83-0304	1.125インチタイプ2ファスナー構造サーフェスマウント型ガス供給システム用2ポートコンポーネント(MFC/MFMを除く)の寸法のための仕様		78
F84-0304	1.125インチタイプ2ファスナー構造サーフェスマウント型ガス供給システム用3ポートコンポーネント(MFC/MFMを除く)の寸法のための仕様		79

設備 (Facilities)

スタンダード番号	タイトル	備考	
F85-0304	1.125インチタイプ4ファスナー構造サーフェスマウント型ガス供給システム用1ポートコンポーネントの寸法のための仕様		80
F86-0304	1.125インチタイプ4ファスナー構造サーフェスマウント型ガス供給システム用2ポートコンポーネント(MFC/MFMを除く)の寸法のための仕様		81
F87-0304	1.125インチタイプ4ファスナー構造サーフェスマウント型ガス供給システム用3ポートコンポーネント(MFC/MFMを除く)の寸法のための仕様		82
F88-0304E	1.5インチタイプサーフェスマウント型ガス供給システム用スタンダードサイズマスフローコントローラ/マスフローメータの寸法のための仕様		83
F89-0304E	1.5インチタイプサーフェスマウント型ガス供給システム用コンパクトサイズマスフローコントローラ/マスフローメータの寸法のための仕様		84
F90-0304E	1.5インチタイプ2ファスナー構造サーフェスマウント型ガス供給システム用スタンダードサイズ2ポートコンポーネント(MFC/MFMを除く)の寸法のための仕様		85
F91-0304E	1.5インチタイプ2ファスナー構造サーフェスマウント型ガス供給システム用コンパクトサイズ2ポートコンポーネント(MFC/MFMを除く)の寸法のための仕様		86
F92-0304E	1.5インチタイプ2ファスナー構造サーフェスマウント型ガス供給システム用コンパクトサイズ3ポートコンポーネントの寸法のための仕様		87
F93-0304E	1.5インチタイプ4ファスナー構造サーフェスマウント型ガス供給システム用1ポートコンポーネントの寸法のための仕様		88
F94-0304E	1.5インチタイプ4ファスナー構造サーフェスマウント型ガス供給システム用2ポートコンポーネント(MFC/MFMを除く)の寸法のための仕様		89
F95-0304E	1.5インチタイプ4ファスナー構造サーフェスマウント型ガス供給システム用3ポートコンポーネントの寸法のための仕様		90
F96-0704	液体CVD原料を入れるキャニスターのポート設定のための仕様		91
F97-0305	設備パッケージの統合、監視、管理のための仕様		92
F98-0305	半導体プロセスにおける用水再処理のためのガイド		93
F99-0705	メトリックPFAチューブ用ダイヤフラムバルブの寸法仕様		94
F100-0705	メトリックPFAチューブ用ダイヤフラムバルブにおける最小流量係数の一定基準の互換性のテスト方法		95
F101-1105	ガス分配システムの圧力レギュレータの性能を決定するための試験方法		96
F102-0306	サーフェスマウント型ガス供給システム用コンポーネントの寸法のための仕様を選択するためのガイド		97
F103-0307	ステンレススチール製液体原料容器(キャニスター)の形状の仕様		98
F104-1107	超純水および液体化学薬品分配システムに使用されるコンポーネント評価のためのパーティクル試験方法ガイドライン		99
F105-0708	ガス供給システムにおける金属材料の適合性ガイド		100
F106-0308	ヘリウム漏れ検出器によるガス供給システムの漏れ完全性を確認するためのテスト方法		101
F108-0310	半導体、フラットパネルディスプレイおよび太陽電池製造用途における薬液配管の集積化に関するガイド	新規	102
F107-0309	プロセス装置アダプタプレートガイド		103
E6-0303	半導体製造装置の設置に関する文書のガイド		Hard
E7-91 (Reapproved 1104)	米国内電氣的インタフェースの仕様		104
E12-0303 (Reapproved 0309)	マスフローメータおよびマスフローコントローラに使用される標準の圧力、温度、密度、および流量単位のスタンダード		105
E16-90 (Reapproved 1104)	マスフローコントローラ漏洩率の決定および記述(ガイドライン)		106
E17-0600 (Reapproved 0307)	マスフローコントローラの過渡特性テストのガイドライン		107
E18-91 (Reapproved 1104)	マスフローコントローラの温度スペック(ガイドライン)		108
E27-92 (Reapproved 1104)	マスフローコントローラおよびマスフローメータの直線性のスタンダード		109
E28-92 (Reapproved 1104)	マスフローコントローラの圧力仕様のガイドライン		110
E29-93 (Reapproved 1104)	マスフローコントローラおよびマスフローメータの校正のための標準用語		111
E31-93	電氣的インタフェース(日本用)		Hard
E33-94	半導体製造設備の電磁適合性のための仕様		112
E34-95	マスフローデバイス返還のためのガイドライン		113

設備 (Facilities)

スタンダード番号	タイトル	備考	
E49-1104	高純度および超高純度配管システムの性能, サブアセンブリ, 最終組立のためのガイド		114
E49.2-1104	半導体処理装置の超純水システムおよび薬液システムで使用されるポリマーアセンブリの資格認定のガイドライン		115
E49.4-0298	半導体製造装置における高純度溶剤供給システムのガイド		116
E49.5-1104	半導体製造装置における超高純度溶剤供給システムのガイド		117
E49.6-1103	サブシステム組立ておよびテスト手順のガイド—ステンレススチールシステム		118
E49.7-0304E	半導体プロセス装置内の超純水およびリキッドケミカルシステムの設計および製造に対する純度のガイド		119
E49.8-1103	半導体製造装置における高純度および超高純度ガス供給システムのガイド		120
E51-0200	一般的設備サービスおよび終端マトリクスのガイド		121
E52-0310	デジタルマスフローコントローラで使用されるガス, ガス混合物および気化して使用する材料の参照表	改訂	122
E56-0309	熱マスフローコントローラの精度, 直線性, リピータビリティ, 短期再現性, ヒステリシス(履歴現象)およびデッドバンドを判断するテスト方法		123
E66-1103	マスフローコントローラのパーティクル発生測定のためのテスト方法		124
E67-0304	マスフローコントローラの信頼性測定のためのテスト方法		125
E68-0997 (Reapproved 0309)	マスフローコントローラのウォームアップ時間測定のためのテスト方法		126
E69-0298 (Reapproved 0309)	サーマルマスフローコントローラの再現性とゼロドリフトを測定するためのテスト方法		127
E70-1103	ツール・アコモデーションのプロセスに対するガイド		128
E76-0299	300 mmプロセス装置を設備サービスに接続するポイントのガイド		129
E77-1104	マスフローコントローラの換算率の代用ガス使用による計算方法		130
E80-0299 (Reapproved 1104)	マスフローコントローラの姿勢感度(取付位置)決定の試験方法		131
E129-0709	半導体製造設備における静電気放電(ESD)の評価と制御へのガイド		Hard
E137-0705	半導体製造装置の最終組立, 梱包, 輸送, 開梱, クリーンルームの製造領域への移送のためのガイド		132

フラットパネルディスプレイ(FPD)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
D3-91 (Reapproved 0709)	FPD基板の有効範囲の仕様		1
D5-94 (Reapproved 0703)	FPD基板の標準サイズ		2
D6-0308	LCDマスク基板の仕様		3
D7-94 (Reapproved 0703)	FPD用ガラス基板の表面粗さの測定方法		4
D9-0303 (Reapproved 0709)	FPD基板の用語		5
D10-95 (Reapproved 0703)	FPD用ガラス基板の耐薬品性テスト方法		6
D11-95 (Reapproved 0709)	FPDガラス基板カセットの仕様		7
D12-95 (Reapproved 0703)	FPD基板のエッジ状態の仕様		8
D13-0708	FPD用カラーフィルタの用語		9
D15-1296 (Reapproved 0703)	FPDガラス基板の表面うねりの測定方法		10
D16-0998	FPDマテリアルハンドリングシステムとツールポート間の機械的インタフェース仕様		11
D17-0200	FPDガラス基板搬送用カセットの機械的仕様		12
D18-0299E	FPD基板水平搬送用および保管用カセット仕様		13
D19-0305	FPD用カラーフィルタの耐薬品性試験方法		14
D20-0706	FPDマスク欠陥の用語		15
D21-0706	FPDマスクパターン精度の用語		16
D22-1109	FPDカラーフィルタ色特性の測定方法		17
D23-0999	FPD製造装置のコスト(CEO)計算のガイド		18
D24-0200 (Reapproved 0706)	FPD用ガラス基板の仕様		19
D25-0600E (Reapproved 0706)	FPDガラス基板輸送用梱包ケースの仕様		20
D26-1000	FPD用大型マスクの暫定仕様(北米地区限定)		21
D27-1000	FPD装置の通信インタフェースのガイド		22
D28-1101 (Reapproved 0708)	AGV, RGV, MGVを用いたFPD用搬送装置とツールポートの間の機械的インタフェースの仕様		23
D29-1101 (Reapproved 0707)	FPDカラーフィルタの耐熱性試験方法		24
D30-0707	FPDカラーフィルタの耐光性試験方法		25
D31-1102	FPD画質検査における輝度ムラの計量単位(Semu)の定義		26
D32-0303 (Reapproved 0709)	FPDガラス基板のオリエンテーションコーナ統一にともなう情報管理改善の仕様		27
D33-0703	バックライトユニットの光学特性の測定方法		28
D34-0703	FPD偏光板の測定方法		29
D35-1103 (Reapproved 0709)	冷陰極型蛍光管(CCFL)特性の測定試験方法		30
D36-0306	LCDバックライトユニットの用語		31
D37-0304	LCD用ベリクルの仕様 2008年7月, D37はD52に書き換えられました。		--
D38-0304	LCD用マスクの有効範囲のガイド		32
D39-0704	FPD偏光板用マーカの仕様		33
D40-0704	FPD基板の「たわみ」に関する用語		34
D41-0305	FPD画質検査におけるSEMIのムラの測定方法		35
D42-0308	超大型マスク基板材料(収納用)ケースの仕様		36
D43-1105	FPD製造用AMHSにおける機械的振動の測定方法		37
D44-0706E	枚葉基板を装置へ搬入出する際の基準位置仕様		38
D45-0706	FPDカラーフィルタ用高抵抗樹脂ブラックマトリックスの抵抗値測定方法		39
D46-0706	FPD偏光板の用語		40
D47-0307	屈曲冷陰極型蛍光管(CCFL)特性の測定試験方法		41
D48-1107	搬送上でのIDリーダーの取付け基準線を規定するための基板IDの基準位置仕様		42
D49-0707	ID読み取り位置を特定するための枚葉基板搬入出時の向きに関する仕様		43
D50-0707	FPD用偏光板の表面硬度の測定方法		44
D51-0709	FPD製造における枚葉搬送のためのハンドシェイク方法の仕様		45
D52-0708E	基板IDの基準位置に関する仕様		46
D53-0708	LCD用ベリクルの仕様		47
D54-0709E	FPD生産における基板管理(SMS-FPD)のための仕様		48
D55-0310	色純度の評価方法のためのガイド	新規	49
D56-0310 ※	Measurement Method for Ambient Contrast of Liquid Crystal Displays	新規	50

フラットパネルディスプレイ(FPD)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
D57-0310 ※	Definition of Measurement Index (VCT) for Mura in FPD Image Quality Inspection	新規	51
D58-0310 ※	Terminology and Test Pattern for the Color Breakup of Field Sequential Color Display	新規	52
T8-0698E (Reapproved 1104)	FPDガラス基板に二次元のマトリクスコードシンボルをマーキングする場合の仕様		Trace.
S26-0709	FPD製造システムの環境, 健康および安全に関するガイドライン		Safety

※印の付いた規格は、本出版サイクルで日本語翻訳版を出版していません。

英語版のみのご提供です。SEMIジャパン オンデマンドライブラリではご提供していません。

ガス (Gases)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
C3-0699	ガスの仕様		1
C3.2-0301	アルシン(AsH ₃), シリンダ充填, 品質99.94%の仕様		2
C3.6-0701	ホスフィン(PH ₃), シリンダ充填, 品質99.98%の仕様		3
C3.12-1109	アンモニア(NH ₃), シリンダ充填, 品質99.998%の仕様		4
C3.20-0309	ヘリウム(He), シリンダ充填, 品質99.9995%の仕様		5
C3.24-0309	六フッ化硫黄(SF ₆), シリンダ充填, 品質99.97%の仕様		6
C3.26-0301	六フッ化タングステン(WF ₆), シリンダ充填, 品質99.8%の仕様		7
C3.27-1102	三フッ化ホウ素(BF ₃), シリンダ充填, 品質99.0%の仕様		8
C3.32-1109	塩素(Cl ₂), 品質99.996%の仕様		9
C3.33-92(Reapproved 0303)	三塩化ホウ素(BCl ₃) (暫定スタンダード)		10
C3.34-1109	シリンダ中のジシラン(Si ₂ H ₆), 品質97%の仕様		11
C3.35-1109	塩化水素(HCl), 品質99.997%の仕様		12
C3.37-1109	六フッ化エタン(C ₂ F ₆), 品質99.97%の仕様		13
C3.39-0304	三フッ化窒素(NF ₃)のスタンダード		14
C3.40-1000	四フッ化炭素(CF ₄), VLSIグレードのスタンダード		15
C3.47-1101	臭化水素(HBr), 品質99.98%の仕様		16
C3.51-1101	三塩化ホウ素(BCl ₃), 品質99.98%の仕様		17
C3.52-0200	六フッ化タングステン, 99.996%品質のスタンダード		18
C3.54-0200	シラン(SiH ₄)のガス純度ガイドライン		19
C3.55-0200	シラン(SiH ₄), バルクのスタンダード		20
C3.56-0600	ジボラン混合ガスの仕様		21
C3.57-0600	シリンダ中の電子的グレード二酸化炭素, CO ₂ の仕様		22
C3.58-0303	八フッ化シクロブタン, C ₄ F ₈ , 電子グレード, シリンダ充填の仕様		23
C6.2-93(Reapproved 1102)	パイプラインガスとして授受されるグレード20/0.02酸素に対するパーティクル仕様		24
C6.3-89(Reapproved 0303)	パイプラインガスとして授受されるグレード20/0.2水素(H ₂)に対するパーティクル仕様		25
C6.4-90(Reapproved 1102)	パイプラインガスとして授受されるグレード20/0.02窒素(N ₂)およびアルゴン(Ar)に対するパーティクル仕様		26
C6.5-90(Reapproved 1102)	パイプラインガスとして授受されるグレード10/0.2窒素(N ₂)およびアルゴン(Ar)に対するパーティクル仕様		27
C6.6-90(Reapproved 1102)	パイプラインガスとして授受されるグレード10/0.1窒素(N ₂)およびアルゴン(Ar)に対するパーティクル仕様		28
C6.7-93(Reapproved 1102)	高圧ガスシリンダ中のグレード10/0.2窒素に対するパーティクル仕様		29
C9.1-93(Reapproved 1102)	重量測定により調製された混合ガスの不確定性の分析に対するガイド		30
C10-1109	MDL(定量下限値)決定に関するガイド		Chemi
C14-95(Reapproved 0309)	25cmガスフィルターカートリッジのパーティクル阻止と性能のためのテスト方法		31
C15-95(Reapproved 1102)	PPMおよびPPB水分標準のためのテスト方法		32
C16-0299(Reapproved 0305)	精度およびデータ報告作業の方法のガイド		Chemi
C52-0301	特殊ガスの貯蔵寿命に関する仕様		33
C54-1103	酸素の仕様とガイドライン		34
C55-1104	近臨界, 臨界, 超臨界用途に使用される液化二酸化炭素(CO ₂)の仕様 ≥ 品質99.99%		35
C56-0305	ジクロロシラン(SiH ₂ Cl ₂)の仕様およびガイドライン		36
C57-0305	アルゴン(Ar)の仕様およびガイドライン		37
C58-0305	水素(H ₂)の仕様およびガイドライン		38
C59-1104	窒素の仕様とガイドライン		39
C60-0305	亜酸化窒素(N ₂ O)の仕様およびガイドライン		40
E140-0305	ガス配送システムのコストオペレーション(COO)の計算ガイド		Hard

材料(Materials)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
M1-1109	鏡面単結晶シリコンウェーハの仕様		1
M6-1108	太陽光電池用シリコンウェーハの仕様		2
M8-0307	鏡面単結晶シリコンテストウェーハの仕様		3
M9-0708	鏡面単結晶ガリウムヒ素スライスの仕様		4
M9.1-96E (Reapproved 0308)	電子デバイス用直径50.8 mm 円形鏡面単結晶ガリウムヒ素ウェーハのスタンダード		5
M9.2-96E (Reapproved 0308)	電子デバイス用直径76.2 mm 円形鏡面単結晶ガリウムヒ素ウェーハのスタンダード		6
M9.3-89	オプトエレクトリック用円形直径2 インチ鏡面単結晶ガリウムヒ素ウェーハ(スタンダード)		7
M9.4-89	オプトエレクトリック用円形直径3 インチ鏡面単結晶ガリウムヒ素ウェーハ(スタンダード)		8
M9.5-96E (Reapproved 0308)	電子デバイス用直径100 mm 円形鏡面単結晶ガリウムヒ素ウェーハのスタンダード		9
M9.6-95E (Reapproved 0308)	円形125 mm 径鏡面単結晶ガリウムヒ素ウェーハのスタンダード		10
M9.7-0708	円形150 mm 径単結晶鏡面ガリウムヒ素ウェーハ(V字型ノッチ付き)の仕様		11
M9.8-0306	円形200 mm径単結晶鏡面ガリウムヒ素ウェーハ(ノッチ付き)の仕様		12
M10-1296	ガリウムヒ素ウェーハに見られる構造および特徴の確認のための標準名称		13
M12-0706	ウェーハ表面の連続英数字マーキングの仕様		14
M13-0706	シリコンウェーハの英数字マーキングの仕様		15
M14-89	半絶縁ガリウムヒ素単結晶のためのイオン注入および活性化プロセス(仕様)		16
M15-0298	半絶縁ガリウムヒ素ウェーハ用の鏡面ウェーハの許容表面欠陥表		17
M16-1103	多結晶シリコンの仕様		18
M17-0704	一般的なウェーハグリッドのガイド		19
M18-1107	シリコンウェーハ注文書記入仕様開発のガイド		20
M19-91	バルク・ガリウムヒ素単結晶基板の電気的性質(仕様)		21
M20-1104	ウェーハ座標システムの確立の作業方法		22
M21-0304	カーテシアン(デカルト)アレイにおける方形エレメントへの割当アドレスのガイド		23
M23-0703	鏡面単結晶インジウムリンウェーハの仕様		24
M23.1-0600	50 mm 鏡面単結晶インジウムリンウェーハの仕様		25
M23.2-1000	3 インチ(76.2mm) 鏡面単結晶燐化インジウムウェーハのスタンダード		26
M23.3-0600	長方形鏡面単結晶インジウムリンウェーハの規格		27
M23.4-0999	電子デバイスならびにオプトエレクトロニクス用途100 mm 径鏡面単結晶インジウムリンウェーハ仕様(ドープテイルタイプ)		28
M23.5-1000	電子デバイスならびにオプトエレクトロニクス用途100 mm 径鏡面単結晶インジウムリンウェーハ仕様(V-GROOVE オプション)		29
M23.6-0703	150 mm鏡面単結晶インジウムリンウェーハ(ノッチ付き)の仕様		30
M24-0307	鏡面単結晶プレミアムシリコンウェーハの仕様		31
M26-0304	ウェーハの運搬に使用されるウェーハボックスおよびカセットの再利用ガイド		32
M29-1296 (Reapproved 1103)	300mm SHIPPINGボックスの仕様		33
M30-0997 (Withdrawn 0309)	フーリエ変換赤外吸収分光法によるGaAs中の置換原子炭素濃度に対する標準テスト方法 2009年3月、M30-0997は撤回が決定されました。		--
M31-0708	300 mmウェーハの搬送および出荷用フロントオープニング・ SHIPPINGボックスの機械仕様		35
M32-0307	統計的仕様のガイド		36
M34-0299	SIMOXウェーハを規定するための指針		37
M35-1107	自動検査により検出されるシリコンウェーハ表面特性の仕様を開発するためのガイド		38
M36-0699	低転位密度GaAs基板のエッチピット密度 (EPD)測定方法		39
M37-0699	低転位密度Inp基板のエッチピット密度 (EPD)測定方法		40
M38-0307	鏡面リクレイムシリコンウェーハの仕様		41
M39-0999	半絶縁GaAs単結晶の抵抗率およびホール係数を測定しホール移動度を決定する方法		42
M40-1109	シリコンウェーハ表面の表面ラフネス測定のガイド		43
M41-0707	電源デバイス/IC用シリコン・オン・インシュレーター (SOI) の仕様		44
M42-1000	化合物半導体エピタキシャルウェーハの仕様		45
M43-1109	ウェーハナノポトグラフィを報告するためのガイド		46
M44-0305	シリコン中の酸素の換算係数ガイド		47
M45-0703	300mmウェーハ SHIPPINGシステムに関する暫定仕様		48
M46-1101E (Reapproved 0309)	ECV法によりエピタキシャル層内のキャリア濃度プロファイルを測定するための試験方法		49
M47-0707	CMOS LSI 用のシリコン・オン・インシュレーター (SOI) ウェーハのための仕様		50

材料(Materials)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
M48-1101	パターン無しシリコン基板上膜によって化学-機械的研磨(CMP)プロセスを評価するためのガイド		51
M49-1108	130 nmから22 nmへの技術世代のシリコンウェーハ用ジオメトリ測定システム規定のためのガイド		52
M50-0310	オーバーレイ法による走査型表面検査システム用捕獲率および偽計数率を決定するための試験方法	改訂	53
M51-0303	GOI(Gate Oxide Integrity)によるシリコンウェーハテスト法		54
M52-0307	130 nm, 90nm, 65nmおよび45nm技術世代シリコンウェーハ用走査型表面検査装置仕様のためのガイド		55
M53-0310	パターンのない半導体ウェーハ表面上に証明済み手法で付着した単分散標準粒子を用いた走査型表面検査システム校正の作業方法	改訂	56
M54-0304	半絶縁性(SI) GaAs材料のパラメータのガイド		57
M55-0308	鏡面単結晶シリコンカーバイドウェーハの仕様		58
M55.1-0308	直径50.8 mm 4Hおよび6H型鏡面単結晶シリコンカーバイドウェーハの仕様		59
M55.2-0308	直径76.2 mm 4H および6H 型鏡面単結晶シリコンカーバイドウェーハの仕様		60
M56-0307	計量装置の測定変動と偏りに起因する費用成分の決定法		61
M57-0706	シリコンアニールウェーハを規定するガイド		62
M58-1109	DMAを基にしたパーティクル堆積システムとプロセス評価のためのテスト方法		63
M59-0310	シリコン技術の用語集	改訂	64
M60-0306E2	シリコンウェーハ評価のためのSiO ₂ の経時絶縁破壊特性の試験方法		65
M61-0307	埋め込み層付きシリコンエピタキシャルウェーハの仕様		66
M62-0309	シリコンエピタキシャルウェーハの仕様		67
M63-0306	ガイドライン: 高分解能のX線回折法によってGaAs基板上的AlGaAs内のAl成分を測定するための試験方法		68
M64-0306	赤外線吸収スペクトル法による絶縁(SI)ガリウムヒ素単結晶内のEL2深いドナー濃度の試験方法		69
M65-0306E2	化合物半導体エピタキシャルウェーハに使用するサファイア基板の仕様		70
M66-0706E	MISフラットバンド電圧—絶縁膜厚法を使った、酸化膜、およびhigh-κゲートスタックの有効仕事関数の算出方法		71
M67-1109	測定した厚さデータ配列からESFQRとESFQD法を使ってウェーハのエッジ近傍形状を決定するための作業方法		72
M68-1109	測定した高さデータ配列から曲率法ZDDを使ってウェーハのエッジ近傍形状を決定するための作業方法		73
M70-1109	パーシャルサイト平坦度を使ってウェーハのエッジ近傍形状を決定するための作業方法		74
M71-0310	CMOS LSI 用シリコン・オン・インシュレーター(SOI)ウェーハのための仕様	改訂	75
M72-0308 (Preliminary)	スキャニングリソグラフィに基づく移動平均検定規準を使ったウェーハ平坦度裁定のためのテスト方法 2008年3月に発行後、2年経過したため、発行を終了しました。		76
M73-0309	測定したウェーハエッジプロファイルから直接的関連性ある特性を抽出する試験方法		77
M74-1108	直径450mmメカニカルハンドリング鏡面ウェーハの仕様		78
M75-0309	鏡面単結晶ガリウムアンチモンスライスの仕様		79
MS1-0307	ウェーハ・ボンディング用アライメント・ターゲットを規定するためのガイド		80
MS2-1109 ※	Test Method for Step-Height Measurements of Thin, Reflecting Films using an Optical Interferometer		81
MS3-0307	MEMSテクノロジーの用語集		82
MS4-1109 ※	Standard Test Method for Young's Modulus Measurements of Thin, Reflecting Films Based on the Frequency of Beams in Resonance		83
MS5-0310 ※	Test Method for Wafer Bond Strength Measurements Using Micro-Chevron Test Structures	改訂	84
MS6-0308 ※	Guide for Design and Materials for Interfacing Microfluidic Systems		85
MS7-0708 ※	Specification for Microfluidic Interfaces to Electronic Device Packages		86
MS8-0309 ※	Guide to Evaluating Hermeticity of MEMS Packages		87

材料(Materials)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
AUX001-0709	LIST OF WAFER SUPPLIER IDENTIFICATION CODES (ウェーハサプライヤID コード表)		--
AUX014-0306	LIST OF JIG SUPPLIER IDENTIFICATION CODES (治具サプライヤID コード表)		--
AUX015-1106	SEMI OCR CHARACTER OUTLINES		--
AUX016-0708	LIST OF CARRIER MAKER IDENTIFICATION CODES		--

※印の付いた規格は、本出版サイクルで日本語翻訳版を出版しておりません。

英語版のみのご提供です。SEMIジャパン オンデマンドライブラリではご提供しておりません。

マイクロリソグラフィ(Microlithography)

SEMI スタンダード番号	タイトル	備考	
P1-0708E	ハードサーフェス・フォトマスク用基板		1
P2-0308	ハードサーフェス・フォトマスク用クロムブランク		2
P3-0308	レジスト付きクロムブランク		3
P5-0704	ペリクルの仕様		4
P6-88(Reapproved 0707)	フォトマスク用レジストレーションマーク		5
P7-0997(Reapproved 1103)	粘性決定方法, 方法A-動粘度		6
P8-0997	フォトレジスト中の水分の測定方法		7
P9-0298	マイクロエレクトロニクス用レジストの機能的なテスト(ガイドライン)		8
P10-0709	フォトマスクオーダーのデータ構造の仕様		9
P11-0308	アルカリ現像溶液に対する全規定度の測定のテスト方法		10
P12-0997	誘導結合プラズマ発光分光法(ICP)によるポジティブ・フォトレジスト中の鉄, 亜鉛, カルシウム, マグネシウム, 銅, ホウ素, アルミニウム, クロム, マンガン, およびニッケルの測定		11
P13-91(Reapproved 1104)	原子吸光分光法によるポジティブフォトレジスト中におけるナトリウムとカリウムの測定		12
P14-0997	黒鉛炉原子吸光分光法によるポジティブフォトレジスト中の錫の測定		13
P15-92(Reapproved 1104)	原子吸光分光法によるポジティブフォトレジスト・メタルイオンフリー(MIF)現像液中のナトリウムとカリウムの測定		14
P16-92(Reapproved 1104)	黒鉛炉原子吸光分光法によるポジティブフォトレジスト・メタルイオンフリー(MIF)現像液中の錫の測定		15
P17-92(Reapproved 0299)	誘導結合プラズマ発光分光法(ICP)によるポジティブ・フォトレジスト・メタルイオンフリー(MIF)現像液における鉄, 亜鉛, カルシウム, マグネシウム, 銅, ホウ素, アルミニウム, クロム, マンガン, およびニッケルの測定		16
P18-92(Reapproved 1104)	ウェーハステップのオーバーレイ能力		17
P19-92(Reapproved 0707)	集積回路製造用メトロロジパターンセル		18
P20-0703	EB レジストパラメータのカタログ公表のガイドライン(提案)		19
P21-92(Reapproved 0703)	マスク描画装置の精度表示ガイドライン		20
P22-0307	フォトマスク欠陥の分類とサイズ定義についてのガイドライン		21
P23-0200(Reapproved 1107)	プログラム欠陥マスクおよびマスク欠陥検査システムの感度分析ベンチマーク手順についてのガイドライン		22
P24-94(Reapproved 1104)	CD測長手順		23
P25-94(Reapproved 1104)	焦点深度および最適焦点深度(仕様)		24
P26-0703	フォトレジストの感度測定用パラメータチェックリスト		25
P27-96(Reapproved 0703)	基板上的レジスト膜厚の測定用パラメータチェックリスト		26
P28-96(Reapproved 0707)	集積回路製造用オーバーレイ計測テストパターン		27
P29-1105	減衰型位相シフトマスク(ハーフトーン型位相シフトマスク)およびマスクブランクスに特有な特性の仕様		28
P30-0997(Reapproved 1104)	寸法測定用走査型電子顕微鏡(CD-SEM)の目録発行の実施要領		29
P31-0304	化学増幅型(CA)フォトレジストパラメータのカタログ発行の作業方法		30
P32-1104	フォトレジスト中のトレースメタル定量のための試験方法		31
P34-0200(Reapproved 0707)	230mm方形フォトマスク基板の仕様		32
P35-1106	マイクロリソグラフィメトロロジの用語法		33
P36-1108	測長走査型電子顕微鏡(CD-SEM)用倍率標準試料のガイド		34
P37-1109 ※	SPECIFICATION FOR EXTREME ULTRAVIOLET LITHOGRAPHY SUBSTRATES AND BLANKS		35
P38-1103	極紫外線リソグラフィマスクブランク上の吸収体層および多層膜の仕様		36
P39-0308	OASIS™ -オープン・アートワーク・システム・インターチェンジ・スタンダード		37
P40-1109 ※	SPECIFICATION FOR MOUNTING REQUIREMENTS FOR EXTREME ULTRAVIOLET LITHOGRAPHY MASKS		38
P41-0304E	XMLによる, 検査装置, 修正装置およびレビュー装置間で取扱うマスク欠陥データ仕様		39
P42-0304	ウェーハ露光システムへの自動レジピ伝送のためのレチクルデータの仕様		40
P43-0304	フォトマスク品質評価用語		41

マイクロリソグラフィ(Microlithography)

SEMI スタンド番号	タイトル	備考	
P44-0709	マスク装置向けオープン・アートワーク・システム・インターチェンジ・スタンダード(OASIS [®])の仕様		42
P45-0708	マスク装置向けジョブデック・データフォーマットの仕様		43
P46-0706	XMLによるフォトマスクのCD計測情報データの仕様		44
P47-0307	ラインエッジラフネス(Line Edge Roughness)およびライン幅ラフネス(Line Width Roughness)測定のテスト方法		45
E100-1104	6インチまたは230 mmのレチクルの搬送および保管に用いられるレチクルSMIFポッド(RSP)の仕様		Hard
E111-1106	6インチレチクルの搬送および保管用150 mm レチクルSMIFポッド(RSP150)の機械仕様		Hard
E112-1106	6インチレチクルの搬送および保管用150 mm複数レチクルSMIFポッド(MRSP150)の機械仕様		Hard

※印の付いた規格は、本出版サイクルで日本語翻訳版を出版していません。

英語版のみのご提供です。SEMIジャパン オンデマンドライブラリではご提供していません。

パッケージング(Packaging)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
G1-96	仕様Cer-DIPパッケージ構造		1
G2-94	CER-DIPパッケージ用金属リードフレームの仕様		2
G3-90	仕様 側面ろう付け積層板		3
G4-0302	スタンピングリードフレーム製品で使用されるICリードフレーム材料の仕様		4
G5-87	仕様 セラミックチップキャリア(CCC)		5
G6-89	検査方法 封止リング平坦度		6
G8-94	試験方法 金めっき		7
G9-89	仕様 スタンピングによる半導体プラスチックDIPパッケージ用リードフレーム		8
G10-96	標準測定方法 プラスチックパッケージリードフレームの機械的測定方法		9
G11-88	測定方法 熱硬化性モールドディングコンパウンドのラムフォロー装置によるゲル化時間およびスパイラルフローの測定		10
G13-88	標準測定方法 モールドディングコンパウンドの膨張特性		11
G14-88	ガイドライン 工具製造用プラスチックモールドDIPパッケージの寸法および公差		12
G15-93	試験方法 モールドディングコンパウンド示差走査熱量分析		13
G16-88	仕様 工具製造用プラスチックモールドPLCCパッケージの工具の寸法および公差		14
G18-96	スタンダード エッチングリードフレームの製造に使用する集積回路用リードフレーム材料		15
G19-0997	仕様 エッチングにより製造されるDIPリードフレーム		16
G20-96	仕様 樹脂材パッケージのリード仕上げ(能動デバイス用)		17
G21-94	ICリードフレームのめっきの仕様		18
G22-1296	仕様 セラミックピングリッドアレイ(PGA)パッケージ		19
G23-0996	試験方法 半導体パッケージの内部導体路のインダクタンス		20
G24-89	試験方法 パッケージ・リード間の容量および付加容量の測定法		21
G25-89	試験方法 パッケージ・リード抵抗の測定法		22
G26-90	仕様 気密性SLAMチップキャリアの蓋		23
G27-89	仕様 プラスチックリードチップキャリア(PLCC)パッケージ用リードフレーム		24
G28-0997	プラスチックモールドS.O.パッケージのリードフレームのための仕様		25
G29-1296E	試験方法 モールドディングコンパウンド中の微量異物検査法		26
G30-88	試験方法 セラミックパッケージのジャンクションとケース間の熱抵抗測定法		27
G31-0997	モールドディングコンパウンドの磨耗特性を測定するためのテスト方法		28
G32-94	カプセルなし熱抵抗測定用チップのガイドライン		29
G33-90	仕様 プレスセラミックピングリッドアレイ(CPGA)パッケージ		30
G34-89	仕様 自動アセンブリ用のリードフレームを含むろう付けリード・フラットパッケージ構造		31
G35-87	仕様 半導体(能動)デバイスのリード仕上げに関する検査方法		32
G36-88	仕様 工具製造用プラスチックモールド高密度TABパッケージの寸法および公差		33
G37-88	仕様 工具製造用プラスチックモールドSOPパッケージの寸法および公差		34
G38-0996(Reapproved 1104)	静止空気および強制風冷によるICパッケージのジャンクション部周囲間の熱抵抗の測定法		35
G39-89	仕様 自動アセンブリ用のリードフレームを含むろう付けリード・フラットパッケージ構造		36
G41-87	仕様 デュアルストリップSOIC用リードフレーム		37
G42-0996(Reapproved 1104)	半導体パッケージのジャンクション部と周囲間の熱抵抗測定用標準熱抵抗測定基板の仕様		38
G43-87	仕様 プラスチックモールドパッケージのジャンクション部とケース間の熱抵抗測定法		39
G44-94	ガラス/メタル封止セラミックパッケージ(能動デバイスのみ)リード仕上げの仕様		40
G45-93	試験方法 熱硬化性モールドディングコンパウンドのフラッシュ特性		41
G46-88	試験方法 集積回路素子取付け評価用熱過渡試験		42
G47-88	仕様 プラスチックモールドクワッドフラットパックリードフレーム		43
G48-89	仕様 モールドプラスチックパッケージ製造工具用測定方法		44
G49-93	仕様 モールドディングコンパウンドのタブレット		45
G50-89	仕様 Co-fired セラミック・ファインピッチキャリア・パッケージの構造(リードおよびリードレス)		46
G51-90	仕様 プラスチックモールド・クワッドフラットパック・リードフレーム		47
G52-90(Reapproved 1104)	半導体リードフレームのイオン汚染物の測定のための標準測定法(提案)		48
G53-92	仕様 金属リッド・プリフォームアセンブリ		49

パッケージング(Packaging)

SEMI スタンドア番号	タイトル	備考	
G54-93	仕様 樹脂封止パッケージ製造用の寸法および公差		50
G55-93(Reapproved 1104)	リードフレーム銀めっき光沢度の測定法		51
G56-93(Reapproved 0302)	試験方法 リードフレーム銀めっき厚さの測定方法		52
G57-0302	ガイドライン リードフレーム各部名称の標準		53
G58-94	CERQUAD パッケージ構造の仕様		54
G59-94(Reapproved 0302)	試験方法: リードフレーム挿入紙上のイオン汚染物および挿入紙からリードフレームに移る汚染物の測定		55
G60-94(Reapproved 0302)	試験方法: 半導体リードフレーム挿入紙材料の静電特性の測定		56
G61-94	焼成セラミックパッケージの仕様		57
G62-95(Reapproved 0302)	試験方法 銀めっき		58
G63-95(Reapproved 0302)	試験方法 ダイ剪断強度の測定		59
G64-96(Reapproved 1104)	全面めっきIC用リードフレーム(金, 銀, 銅, ニッケル, パラジウム/ニッケル, およびパラジウム)の仕様		60
G65-96(Reapproved 1104)	Lリード(ガルウイング型)パッケージ用リードフレーム材料の評価の試験方法		61
G66-96(Reapproved 1104)	半導体用プラスチックモールドコンパウンドの吸湿特性の測定の試験方法		62
G67-0996(Reapproved 1104)	シート材料から発生する粒子の測定の試験方法		63
G68-0996(Reapproved 1104)	空気環境における半導体パッケージのジャンクション部とケース間の熱抵抗測定の試験方法		64
G69-0996(Reapproved 1104)	リードフレームとモールドコンパウンド間の接着強度の測定の試験方法		65
G70-0996(Reapproved 1104)	プラスチックパッケージリードフレーム測定用装置とリードフレーム支持具の標準		66
G71-0996(Reapproved 1104)	パッケージング材料の中間容器のバーコードマーキング仕様		67
G72-0997	ボールグリッドアレイ設計ライブラリのための仕様		68
G72.1-0997	ボールグリッドアレイ設計ライブラリのための設計提案: 292 ピンプラスチックボールグリッドアレイ		69
G72.2-0997	ボールグリッドアレイ設計ライブラリのための設計提案: 388 ピンプラスチックボールグリッドアレイ		70
G73-0997(Reapproved 1104)	ワイヤボンディングに関するプル強度のための試験方法		71
G74-0699(Reapproved 0706)	300 mmウェーハに関するテープフレームのための仕様		72
G75-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープの諸性質の標準的なテスト方法		73
G75.1-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープにおけるイオン不純物の測定のための試験方法		74
G75.2-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープの接着強度の測定のための試験方法		75
G75.3-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープ上の保護フィルムの剥離強度の測定のための試験方法		76
G75.4-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープの吸収率の測定のための試験方法		77
G75.5-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープの加熱重量減少率の測定のための試験方法		78
G75.6-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープの加熱収縮率の測定のための試験方法		79
G75.7-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープおよび接着剤の熱分解温度の測定のための試験方法		80
G75.8-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープの熱膨張係数およびガラス転移温度の測定のための試験方法		81
G75.9-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープの引張り強度, 伸び, および引張弾性率の測定のための試験方法		82
G75.10-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープの体積および表面抵抗率の測定のための試験方法		83
G75.11-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープの誘電率および誘電正接の測定のための試験方法		84
G75.12-0698(Reapproved 0706)	リードフレームテープの絶縁破壊強度の測定のための試験方法		85

パッケージング(Packaging)

SEMI スタンドアード番号	タイトル	備考	
G75.13-0698 (Reapproved 0706)	リードフレームテープにおける漏れ電流の測定のための試験方法		86
G76-0299 (Reapproved 0706)	TCP用ポリイミド接着テープの仕様		87
G77-0699 (Reapproved 0706)	300 mmウェーハ用フレームカセットの仕様		88
G78-0699	プロセス特定測定を利用する自動ウェーハプローブシステム比較試験法		89
G79-0200	総合的デジタルタイミング精度の仕様		90
G80-0200	自動試験装置の総合的デジタルタイミング精度を分析するための試験方法		91
G81-0307	マップデータ・アイテムの仕様		92
G81.1-0307	基板上のダイの特性に関するマップデータの基本概念の規定		93
G82-0301E (Reapproved 0706)	後工程におけるフレームカセット用300mmロードポート暫定仕様		94
G83-0301 (Reapproved 0308)	製品パッケージのバーコードマーキング仕様		95
G84-0303	ストリップマップ・プロトコル用仕様		96
G85-0703	マップデータ・フォーマット用仕様		97
G86-0303	シリコンチップ(ダイ)の三点曲げテスト方法		98
G87-1108	300 mmウェーハに関する樹脂テープフレームのための仕様		99
T9-0200 (Reapproved 1104)	二次元データマトリクスコードシンボルを使用した金属製リードフレームストリップのマーキングに関する仕様		Trace.

太陽光発電(Photovoltaic)

SEMI スタンドアード番号	タイトル	備考	
PV1-0709	高分解能グロー放電質量分析を用いたシリコン太陽電池用シリコン原料中の微量元素測定に関するテスト方法		1
PV2-0709E	PV製造装置通信インタフェース(PVECI)	編集上の修正	2
PV3-0310	太陽電池加工に用いる高純度水に関するガイド	新規	3

プロセスケミカル(Process Chemicals)

SEMI スタンド番号	タイトル	備考	
C1-0310	液体化学薬品の分析のためのガイド	新規	1
C10-1109	MDL(定量下限値)決定に関するガイド		2
C16-0299(Reapproved 0305)	精度およびデータ報告作業の方法のガイド		3
C18-0708	酢酸の仕様		4
C19-0708	アセトンの仕様		5
C20-1101	フッ化アンモニウム40%溶液の仕様とガイドライン		6
C21-0708	水酸化アンモニウムの仕様とガイドライン		7
C22-0306	三臭化ボロンのガイドライン		8
C23-0708	バッファー酸腐食剤の仕様		9
C24-0301	酢酸n-ブチルの仕様		10
C25-0306	ジクロロメタン(塩化メチレン)の仕様		11
C26-0306	ヘキサメチルジシラザン(HMDS)の仕様とガイドライン		12
C27-0708	塩酸の仕様とガイドライン		13
C28-0306	フッ化ケイ素酸の仕様		14
C29-0301	4.9%フッ化ケイ素酸(10:1 V/V)の仕様とガイドライン		15
C30-1101	過酸化水素の仕様とガイドライン		16
C31-0708	メタノールの仕様		17
C32-0306	メチルエチルケトンの仕様		18
C33-0301	N-メチル-2-ピロリドンの仕様		19
C34-0306	混合酸腐食剤の仕様とガイドライン		20
C35-0708	硝酸の仕様とガイドライン		21
C36-1107	りん酸の仕様		22
C37-0706	りん腐食剤の仕様		23
C38-0306	オキシ塩化りんのガイドライン		24
C39-1105	水酸化カリウム(固体)の仕様		25
C40-1105	水酸化カリウム45%溶液の仕様		26
C41-0705	2-プロパノールの仕様とガイドライン		27
C42-1105	水酸化ナトリウム(固体)の仕様		28
C43-1105	水酸化ナトリウム50%溶液の仕様		29
C44-0708	硫酸の仕様とガイドライン		30
C45-0309E	テトラエトキシシラン(TEOS)ガイドラインと仕様		31
C46-0306	25%テトラメチル水酸化アンモニウムのガイドライン		32
C47-0706	トランス1, 2ジクロロエチレンのガイドライン		33
C48-0706	1,1,1トリクロロエタン, ファーネスグレードの仕様とガイドライン		34
C49-1105	トリメチルホウ酸の仕様およびガイドライン		35
C50-1105	トリメチルホスフィンの仕様およびガイドライン		36
C51-0706	キシレンの仕様		37
C53-0704	ジメチルスルホキシド(DMSO)[グレード1および2]の仕様		38
C61-0707	バーコードによる容器識別のための仕様		39
C62-0309	Low-k材のCVDプロセスに使用するボロジェンのプリカーサーの仕様		40
C63-1108	Low-k材のCVDプロセスに使用する有機ケイ酸(organo-silicate)のプリカーサーの仕様		41
C64-0308	統計的出荷管理に関するSEMIガイドライン		42
C65-0308	トリメチルシラン(3MS), 99.995%品質のガイドライン		43
C66-0308	トリメチルアルミニウム(TMAI), 99.5%品質のガイドライン		44
P11-0308	アルカリ現像溶液に対する全規定度の測定のテスト方法		Micro

安全ガイドライン(Safety Guidelines)

SEMIスタンダード番号	タイトル	備考	
S1-0708E	装置安全ラベルの安全ガイドライン		1
S2-0310	半導体製造装置の環境, 健康, 安全に関するガイドライン	改訂	2
S3-0306	プロセス用液体の加熱システムに関する安全ガイドライン		3
S4-0304	分配キャビネット内に格納される化学物質シリンダの分離のための安全ガイドライン		4
S5-0310	流量制限デバイスの安全ガイドライン	改訂	5
S6-0707E	半導体製造装置の排気換気に関する環境, 健康, 安全のためのガイドライン		6
S7-0310	評価要員および評価会社の資質に関する安全ガイドライン	改訂	7
S8-0308	半導体製造装置の人間工学エンジニアリングに対する安全ガイドライン		8
S9-0307	SEMI S22へ移行している半導体製造装置の電気設計検証テストのガイド		9
S10-0307	リスクアセスメントおよびリスク評価のための安全ガイドライン		10
S12-0309	装置の汚染除去に対するガイドライン		11
S13-0305	半導体製造装置と共に使用することが意図された装置ユーザへの提供文書のための環境, 健康, 安全ガイドライン		12
S14-0309	半導体製造装置に対する火災リスクアセスメントと軽減のための安全ガイドライン		13
S16-0307	製品寿命時の環境影響を削減するための半導体製造装置設計ガイド		14
S17-0701	無人搬送台車(UTV)システムの安全ガイドライン		15
S18-1102	シラン系ガスの取り扱いに対する環境, 健康, および安全ガイドライン		16
S19-1102	半導体製造装置の設置, 保守, サービス要員のトレーニングのための安全ガイドライン		17
S20-0303 (Withdrawn 1108)	危険なエネルギーの管理のためのエネルギー遮断デバイスの識別と文書化のための安全ガイドライン 2008年11月, S20-0303は撤回が決定されました。		--
S21-1106E	作業員保護のための安全ガイドライン		18
S22-0709a	半導体製造装置の電気設計のための安全に関するガイドライン	時限付改訂	19
S23-0708	半導体製造装置で使用されるエネルギー, ユーティリティ, および材料の保全のためのガイド		20
S24-0306	複数企業同時作業エリアの安全ガイドライン		21
S25-0706	過酸化水素の貯蔵および取り扱いのための安全ガイドライン		22
S26-0709	FPD製造システムの環境, 健康および安全に関するガイドライン		23
S27-0310	環境, 健康, 安全(ESH)評価報告書の内容に関する安全ガイドライン	新規	24
F15-0308	筐体の試験方法(六フッ化硫黄のトレーサガス)のSEMI S6への移行		Facil
AUX004-1100	SEMI S2-0200 FIRE SAFETY EVALUATION CHECKLIST FOR SEMICONDUCTOR EQUIPMENT USING HAZARDOUS PRODUCTION MATERIALS		--
AUX005-1101	SEMI S-93AとS2-0200の比較表		--
AUX007-0401	Comparison between SEMI S2-93A and KOSHA S Mark		--

シリコンマテリアル&テスト方法 (Silicon Materials Process Control)

SEMI スタンドアード番号	タイトル	備考	
ME1392-1109	Guide for Angle Resolved Optical Scatter Measurements on Specular or Diffuse Surfaces		1
MF26-0305	Test Methods for Determining the Orientation of a Semiconductive Single Crystal		2
MF28-0707	Test Methods for Minority Carrier Lifetime in Bulk Germanium and Silicon by Measurement of Photoconductivity Decay		3
MF42-1105	Test Methods for Conductivity Type of Extrinsic Semiconducting Materials		4
MF43-0705	Test Methods for Resistivity of Semiconductor Materials		5
MF81-1105	Test Method for Measuring Radial Resistivity Variation on Silicon Wafers		6
MF84-0307	Test Method for Measuring Resistivity of Silicon Wafers with an In-Line Four-Point Probe		7
MF95-1107	Test Method for Thickness of Lightly Doped Silicon Epitaxial Layers on Heavily Doped Silicon Substrates Using an Infrared Dispersive Spectrophotometer		8
MF110-1107	Test Method for Thickness of Epitaxial or Diffused Layers in Silicon by the Angle Lapping and Staining Technique		9
MF154-1105	Guide for Identification of Structures and Contaminants Seen on Specular Silicon Surfaces		10
MF374-0307	Test Method for Sheet Resistance of Silicon Epitaxial, Diffused, Polysilicon, and Ion-Implanted Layers using an In-Line Four-Point Probe with the Single-Configuration Procedure		11
MF391-0310	Test Methods for Minority Carrier Diffusion Length in Extrinsic Semiconductors by Measurement of Steadystate Surface Photovoltage	改訂	12
MF397-1106	Test Method for Resistivity of Silicon Bars Using a Twopoint Probe		13
MF523-1107	Practice for Unaided Visual Inspection of Polished Silicon Wafer Surfaces		14
MF525-0307	Test Method for Measuring Resistivity of Silicon Wafers Using a Spreading Resistance Probe		15
MF533-0310	Test Method for Thickness and Thickness Variation of Silicon Wafers	改訂	16
MF534-0707	Test Method for Bow of Silicon Wafers		17
MF576-0706	Test Method for Measurement of Insulator thickness and Refractive Index on Silicon Substrates by Ellipsometry		18
MF657-0707E	Test Method for Measuring Warp and Total Thickness Variation on Silicon Wafers by Noncontact Scanning		19
MF671-0707	Test Method for Measuring Flat Length on Wafers of Silicon and Other Electronic Materials		20
MF672-0307	Guide for Measuring Resistivity Profiles Perpendicular to the Surface of a Silicon Wafer Using a Spreading Resistance Probe		21
MF673-1105	Test Methods for Measuring Resistivity of Semiconductor Wafers or Sheet Resistance of Semiconductor Films with a Noncontact Eddy-Current Gauge		22
MF674-0705	Practices for Preparing Silicon for Spreading Resistance Measurements		23
MF723-0307E	Practice for Conversion between Resistivity and Dopant or Carrier Density for Boron-Doped, Phosphorus-Doped, and Arsenic-Doped Silicon		24
MF728-1106	Practice for Preparing an Optical Microscope for Dimensional Measurements		25
MF847-0705	Test Methods for Measuring Crystallographic Orientation of Flats on Single Crystal Silicon Wafers by X-Ray Techniques		26

シリコンマテリアル&テスト方法 (Silicon Materials Process Control)

SEMI スタンドアード番号	タイトル	備考	
MF928-0305	Test Methods for Edge Contour of Circular Semiconductor Wafers and Rigid Disk Substrates		27
MF950-1107	Test Method for Measuring the Depth of Crystal Damage of a mechanically Worked Silicon Wafer Surface by Angle Polishing and Defect Etching		28
MF951-0305	Test Method for Determination of Radial Interstitial Oxygen Variation in Silicon Wafers		29
MF978-1106	Test Method for Characterizing Semiconductor Deep Levels by Transient Capacitance Techniques		30
MF1048-1109	Test Method for Measuring Reflective Total Integrated Scatter		31
MF1049-0308	Practice for Shallow Etch Pit Detection on Silicon Wafers		32
MF1152-0305	Test Methods for Dimensions of Notches on Silicon Wafers		33
MF1153-1106	Test Method for Characterization of Metal-Oxide-Silicon (MOS) Structures by Capacitance-Voltage Measurements		34
MF1188-1107	Test Method for Interstitial Oxygen Content of Silicon by Infrared Absorption with Short Baseline		35
MF1239-0305	Test Method for Oxygen Precipitation Characteristics of Silicon Wafers by Measurement of Interstitial Oxygen Reduction		36
MF1366-0308	Test Method for Measuring Oxygen Concentration in Heavily Doped Silicon Substrates by Secondary Ion Mass Spectrometry		37
MF1388-0707	Test Method for Generation Lifetime and Generation Velocity of Silicon Material by Capacitance-Time Measurements of Metal-Oxide-Silicon (Mos) Capacitors		38
MF1389-0704	Test Methods for Photoluminescence Analysis of Single Crystal Silicon for III-V Impurities		39
MF1390-0707	Test Method for Measuring Warp on Silicon Wafers by Automated Non-Contact Scanning		40
MF1391-1107	Test Method for Substitutional Atomic Carbon Content of Silicon by Infrared Absorption		41
MF1392-0307	Test Method for Determining Net Carrier Density Profiles in Silicon Wafers by Capacitance-Voltage Measurements with a Mercury Probe		42
MF1451-0707	Test Method for Measuring Sori on Silicon Wafers by Automated Non-Contact Scanning		43
MF1527-0307	Guide for Application of Certified Reference Materials and Reference Wafers for Calibration and Control of Instruments for Measuring Resistivity of Silicon		44
MF1528-0308	Test Method for Measuring Boron Contamination in Heavily Doped <i>n</i> -Type Silicon Substrates by Secondary Ion Mass Spectrometry		45
MF1529-1104	Test Method for Sheet Resistance Uniformity Evaluation by In-Line Four-Point Probe with the Dual-Configuration Procedure		46
MF1530-0707	Test Method for Measuring Flatness, Thickness, and Total Thickness Variation on Silicon Wafers by Automated Non-Contact Scanning		47
MF1535-0707	Test Method for Carrier Recombination Lifetime in Silicon Wafers by Non-Contact Measurement of Photoconductivity Decay by Microwave Reflectance		48
MF1569-0307	Guide for Generation of Consensus Reference Materials for Semiconductor Technology		49
MF1617-0304	Test Method for Measuring Surface Sodium, Aluminum, Potassium, and Iron on Silicon and EPI Substrates by Secondary Ion Mass Spectrometry		50
MF1618-1104	Practice for Determination of Uniformity of Thin Films on Silicon Wafers		51
MF1619-1107	Test Method for Measurement of Interstitial Oxygen Content of Silicon Wafers by Infrared Absorption Spectroscopy with <i>p</i> -Polarized Radiation Incident at the Brewster Angle		52

シリコンマテリアル&テスト方法 (Silicon Materials Process Control)

SEMI スタンドアード番号	タイトル	備考	
MF1630-1107	Test Method for Low Temperature FT-IR Analysis of Single Crystal Silicon for III-V Impurities		53
MF1708-1104	Practice for Evaluation of Granular Polysilicon by Melter-Zoner Spectroscopies		54
MF1723-1104	Practice for Evaluation of Polycrystalline Silicon Rods by Float-Zone Crystal Growth and Spectroscopy		55
MF1724-1104	Test Method for Measuring Surface Metal Contamination of Polycrystalline Silicon by Acid Extraction-Atomic Absorption Spectroscopy		56
MF1725-1103	Practice for Analysis of Crystallographic Perfection of Silicon Ingots		57
MF1726-1103	Practice for Analysis of Crystallographic Perfection of Silicon Wafers		58
MF1727-0304	Practice for Detection of Oxidation Induced Defects in Polished Silicon Wafers		59
MF1763-0706	Test Methods for Measuring Contrast of a Linear Polarizer		60
MF1771-0304	Test Method for Evaluating Gate Oxide Integrity by Voltage Ramp Technique		61
MF1809-0704	Guide for Selection and Use of Etching Solutions to Delineate Structural Defects in Silicon		62
MF1810-0304	Test Method for Counting Preferentially Etched or Decorated Surface Defects in Silicon Wafers		63
MF1811-0310	Guide for Estimating the Power Spectral Density Function and Related Finish Parameters from Surface Profile Data	改訂	64
MF1982-1103	Test Methods for Analyzing Organic Contaminants on Silicon Wafer Surfaces by Thermal Desorption Gas Chromatography		65
MF2074-0707	Guide for Measuring Diameter of Silicon and Other Semiconductor Wafers		66
MF2139-1103	Test Method for Measuring Nitrogen Concentration in Silicon Substrates by Secondary Ion Mass Spectrometry		67
MF2166-0304	Practices for Monitoring Non-Contact Dielectric Characterization Systems Through Use of Special Reference Wafers		68

上記文書はSEMIの標準化プロセスを経て正式にSEMIスタンダードとして承認されたIEASTMDキュメントです。

英語版のみのご提供です。SEMIジャパン オンデマンドライブラリではご提供しておりません。

トレーサビリティ(Traceability)

SEMI スタンド番号	タイトル	備考	
T1-95(Withdrawn 0709)	シリコンウェーハの裏面にバーコードをマーキングする場合の仕様 本文書は、2009年7月、撤回が決定されました。		1
T2-0298(Reapproved 1104)	ウェーハ表面への二次元マトリクスコードシンボルのマーキングの仕様		2
T3-0302(Reapproved 1108)	ウェーハボックスラベルの仕様		3
T4-0301(Reapproved 0307)	150mmおよび200mm POD識別寸法の仕様		4
T5-1106	円形ガリウムヒ素ウェーハの英数字マーキングの仕様		5
T6-0697(Reapproved 1104)	電子的データ交換(EDI)による試験結果報告の手順と書式		6
T7-0303(Reapproved 0709)	二次元マトリクスコードシンボルの両面研磨ウェーハ裏面マーキングの仕様		7
T8-0698E(Reapproved 1104)	FPDガラス基板に二次元のマトリクスコードシンボルのマーキングする場合の仕様		8
T9-0200(Reapproved 1104)	二次元データマトリクスコードシンボルを使用した金属製リードフレームストリップのマーキングに関する仕様		9
T10-0701(Reapproved 0307)	2次元データマトリクス直接マーク品質を評価するテスト方法		10
T11-0703(Reapproved 0709)	ハードサーフェス・レチクル基板のマーキングの仕様		11
T12-1105	治具と工具のトラッキングに関する仕様		12
T12.1-0704	治具トラッキングのSECSプロトコルのための規定		13
T12.2-1105	治具トラッキングのXMLプロトコルのための規定		14
T13-1104	デバイストラッキング:概念, 動作, サービスの仕様		15
T13.1-1104	デバイストラッキング用SECSプロトコルの規定		16
T13.2-1104	デバイストラッキング用XMLプロトコルの規定		17
T14-0705	300 mmシリコンウェーハ上へのMicro ID仕様		18
T14.1-0705	ペベル部で垂直方向が短い300 mmシリコンウェーハ上へのMicro ID仕様		19
T15-0705	治具IDの一般仕様(コンセプト)		20
T16-0310 ※	Specification for Use of Data Matrix Symbology for Automated Identification of Extreme Ultraviolet Lithography Masks	改訂	21
T17-0706	基板トレーサビリティの仕様		22
T18-1106	部品と構成機器に関するトレーサビリティの規定		23
T19-1109 ※	Specification for Device Marking		24
T20-1109 ※	Specification for Authentication of Semiconductors and Related Products		25
T20.1-1109 ※	Specification for Object Labeling to Authenticate Semiconductors and Related Products in an Open Market		26
T20.2-1109 ※	Guide for Qualifications of Authentication Service Bodies for Detecting and Preventing Counterfeiting of Semiconductors and Related Products		27
G71-0996(Reapproved 1104)	パッケージング材料の中間容器のバーコードマーキング仕様		Pack.
G83-0301(Reapproved 0308)	製品パッケージのバーコードマーキング仕様		Pack.
M12-0706	ウェーハ表面の連続英数字マーキングの仕様		Mate.
M13-0706	シリコンウェーハの英数字マーキングの仕様		Mate.
AUX001-0709	LIST OF WAFER SUPPLIER IDENTIFICATION CODES(ウェーハサプライヤIDコード表)		--
AUX014-0306	LIST OF JIG SUPPLIER IDENTIFICATION CODES(治具サプライヤIDコード表)		--
AUX015-1106	SEMI OCR CHARACTER OUTLINES		--
AUX016-0708	LIST OF CARRIER MAKER IDENTIFICATION CODES		--

※印の付いた規格は、本出版サイクルで日本語翻訳版を出版しておりません。

英語版のみのご提供です。SEMIジャパン オンデマンドライブラリではご提供しておりません。